

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/004894

International filing date: 14 March 2005 (14.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-073059
Filing date: 15 March 2004 (15.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 20 May 2005 (20.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 3 月 1 5 日
Date of Application:

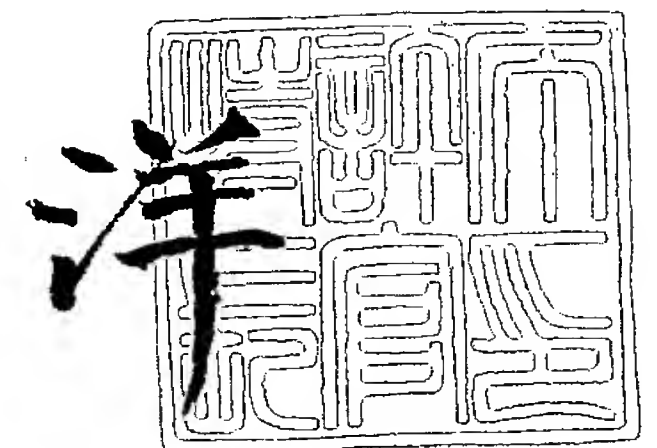
出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 0 7 3 0 5 9
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 4 - 0 7 3 0 5 9]

出 願 人 昭 和 電 工 株 式 有 限 公 司
Applicant(s):

2 0 0 5 年 3 月 1 5 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 11H160090
【提出日】 平成16年 3月15日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 21/18
【発明者】
 【住所又は居所】 埼玉県秩父市大字下影森 1 5 0 5 番地 昭和電工株式会社 秩父事業所内
 【氏名】 竹内 良一
【発明者】
 【住所又は居所】 埼玉県秩父市大字下影森 1 5 0 5 番地 昭和電工株式会社 秩父事業所内
 【氏名】 宇田川 隆
【特許出願人】
 【識別番号】 000002004
 【氏名又は名称】 昭和電工株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100064908
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 志賀 正武
【選任した代理人】
 【識別番号】 100108578
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 高橋 詔男
【選任した代理人】
 【識別番号】 100089037
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 渡邊 隆
【選任した代理人】
 【識別番号】 100101465
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 青山 正和
【選任した代理人】
 【識別番号】 100094400
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 鈴木 三義
【選任した代理人】
 【識別番号】 100107836
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 西 和哉
【選任した代理人】
 【識別番号】 100108453
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 村山 靖彦
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 008707
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9704938

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

III-V 族化合物半導体からなる発光層と、該発光層上に設けられた III-V 族化合物半導体からなる電流拡散層とを備えた化合物半導体発光ダイオードにおいて、

前記電流拡散層が、導電性のリン化硼素系半導体から構成され、

前記電流拡散層の室温での禁止帯幅が、前記発光層の室温での禁止帯幅よりも大きいことを特徴とする化合物半導体発光ダイオード。

【請求項 2】

前記電流拡散層が、単量体のリン化硼素、組成式 $B_{\alpha}Ga_{\gamma}In_{1-\alpha-\gamma}P$ ($0 < \alpha \leq 1$, $0 \leq \gamma < 1$) で表されるリン化硼素・ガリウム・インジウム、組成式 $B_{\alpha}P_{1-\delta}N_{\delta}$ ($0 \leq \delta < 1$) で表される窒化リン化硼素、組成式 $B_{\alpha}P_{1-\delta}As_{\delta}$ で表される砷化リン化硼素から選択された少なくとも一種以上から構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の化合物半導体発光ダイオード。

【請求項 3】

前記電流拡散層の室温での禁止帯幅と、前記発光層の室温での禁止帯幅との差が、 0.1 eV 以上であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の化合物半導体発光ダイオード。

【請求項 4】

前記電流拡散層の室温での禁止帯幅が、 $2.8 \text{ eV} \sim 5.0 \text{ eV}$ であることを特徴とする請求項 1 乃至 3 の何れか 1 項に記載の化合物半導体発光ダイオード。

【請求項 5】

前記電流拡散層は、その室温でのキャリア濃度が $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上であり、抵抗率が $5 \times 10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下であり、厚さが 50 nm 以上、 5000 nm 以下であることを特徴とする請求項 1 乃至 4 の何れか 1 項に記載の化合物半導体発光ダイオード。

【請求項 6】

前記電流拡散層と前記発光層との間に、III-V 族化合物半導体からなるクラッド層が備えられ、

前記クラッド層の室温での禁止帯幅が、前記発光層の室温での禁止帯幅よりも大きく、かつ前記電流拡散層の室温での禁止帯幅以下であることを特徴とする請求項 1 乃至 5 の何れか 1 項に記載の化合物半導体発光ダイオード。

【請求項 7】

前記クラッド層がアルミニウム、ガリウム、及びインジウムを含有する III-V 族化合物半導体から構成され、

前記電流拡散層は、アルミニウム、ガリウム、インジウムのうち少なくとも一種以上を含むリン化硼素系半導体から構成されていることを特徴とする請求項 6 に記載の化合物半導体発光ダイオード。

【請求項 8】

前記電流拡散層と前記クラッド層として、リン化硼素系半導体から構成され、組成に勾配を付した組成勾配層が備えられていることを特徴とする請求項 6 又は 7 に記載の化合物半導体発光ダイオード。

【請求項 9】

前記発光層が、組成式 $Al_xGa_yIn_zP$ ($0 \leq X, Y, Z \leq 1$, $X + Y + Z = 1$) で表されるリン化アルミニウム・ガリウム・インジウム混晶から構成され、

前記電流拡散層又は前記クラッド層が、不純物を故意に添加していないアンドープのリン化硼素系半導体から構成されていることを特徴とする請求項 1 乃至 8 の何れか 1 項に記載の化合物半導体発光ダイオード。

【請求項 10】

前記電流拡散層又は前記組成勾配層には、オーミック接触性の電極が接合されていることを特徴とする請求項 1 乃至 9 の何れか 1 項に記載の化合物半導体発光ダイオード。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 化合物半導体発光ダイオード

【技術分野】

【0001】

本発明は、III-V族化合物半導体層を発光層とする化合物半導体発光ダイオード（light-emitting diode、以下LEDとも言う。）において、LEDの駆動電流を発光層の広範囲に亘り拡散させるための電流拡散層を備え、高い発光強度が得られる化合物半導体発光ダイオードに関する。

【背景技術】

【0002】

緑色帯から赤色帯の光を発光するLEDとして、発光層がリン化アルミニウム・ガリウム・インジウム混晶（組成式 $Al_xGa_yIn_zP$ ： $0 \leq X, Y, Z \leq 1$ 、 $X+Y+Z=1$ ）から構成されているLEDが知られている（非特許文献1参照。）。

非特許文献1に開示されたように、短波長の可視光を発光するための発光層は、通常、 $Al_xGa_yIn_zP$ から構成され、室温での禁止帯幅が2エレクトロンボルト（単位：eV）程度と比較的大きい。

このような発光層には、放射再結合の効率を向上させて、高強度の発光を得るために、クラッド（clad）層を異種（hetero）接合させて異種接合構造の発光部とするのが通例である。

【0003】

例えば、 $Al_xGa_yIn_zP$ からなる発光層にあって、障壁層として異種接合させるクラッド層は、発光層よりも大きな禁止帯幅の $Al_xGa_yIn_zP$ から構成される。キャリアの「閉じ込め」効果をもたらす一方で、大きな禁止帯幅の半導体層とする必要性から、一般にクラッド層は素子を駆動するための電流（素子駆動電流）を発光層の広範囲に拡散させるに不十分となっている。

このため、従来技術では、クラッド層上には、発光層に素子駆動電流を平面的に拡散させることを目的とした電流拡散層を設ける技術が開示されている（特許文献1参照。）。

【0004】

電流拡散層は、素子動作電流を平面的に拡散させるために、比較的禁止帯幅の小さい（例えば発光層よりも禁止帯幅の小さい）半導体材料から構成されている。

例えば、橙色帯或いは赤色帯発光用の化合物半導体発光ダイオードとして、 $Al_xGa_yIn_zP$ から構成された発光層上に、砒化アルミニウム・ガリウム（組成式 Al_xGa_yAs ： $0 \leq X, Y \leq 1$ ）からなる電流拡散層が備えられたものが開示されている（例えば、特許文献2の第4頁段落0010参照。）。

しかしながら、このように禁止帯幅が小さい半導体材料から構成された電流拡散層は、発光層から発せられた光を原理的に吸収してしまう。従って、高強度の発光を得るために発光部を異種接合構造としても、従来の電流拡散層が発光部上の発光の取り出し方向に設けられた構成では、必ずしも高強度のLEDを安定して得るに至らない。

【0005】

一方で、電流拡散層が、インジウム・錫複合酸化膜（略称：ITO）等の光学的に透明な材料から構成されたLEDが開示されている（例えば、特許文献3参照。）。

ITO等の透明酸化物は禁止帯幅も高く、また、低抵抗であるため、発光を外部へ取り出すための窓（window）層を兼用する電流拡散層を構成する材料として利用できる。

しかし、一般に透明酸化物は、III-V族化合物半導体とのオーミック（ohmic）接触性を安定して確保することが難しく、これにより素子駆動電流を広範囲に拡散し難くなる場合があった。

これを克服するために特許文献3では、III-V族化合物半導体層から成るクラッド層の表面に複数のオーミック性電極を分散させて配置させることにより、素子駆動電流を発光層に拡散させる技術が開示されている。

しかし、オーミック電極を分散して配置しようとする、例えば、LEDを製造するための工程が煩雑となる欠点となっている。

【特許文献1】米国特許第5008718号公報

【特許文献2】特開平11-4020号公報

【特許文献3】特開2001-144330号公報

【非特許文献1】Y. Hosokawa (ワイ・ホソカワ) 他、ジャーナル オブ クリスタル グロース (J. Crystal Growth)、第221巻、2000年(オランダ)、652~656頁

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

LEDを構成する電流拡散層は、素子駆動電流を発光層の広範囲に十分に拡散でき、尚且つ、発光層からの発光を吸収せずに外部へ取り出せる光学的に透明な材料から構成する必要がある。このためには、電流拡散層の常温での禁止帯幅が、発光層の常温での禁止帯幅を超える広い値とする必要がある。

しかし、電流拡散層を構成する材料として、従来から用いられている $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{As}$ ($0 \leq x, y \leq 1$) では、十分に低い抵抗の導電層を形成し難い問題がある。従って、素子駆動電流を拡散させるに十分な電流拡散層を安定して形成でき得ていない欠点がある。

【0007】

また、亜鉛(Zn)を構成元素として含むIII-V族化合物半導体層は、酸化され易いため、動作信頼性に優れる発光素子とするためには、耐酸化用途の保護膜を必要とする等、素子作製工程上、煩雑さをともなう場合があった。

【0008】

また、電流拡散層として利用されている別の材料であるITO等の酸化物材料は、例えば、クラッド層をなすIII-V族化合物半導体と良好なオーミック接触性が安定して得られない。このため、例えば透明酸化物材料からなる電流拡散層と、クラッド層との間の抵抗値が大きくなってしまい、順方向電圧(Vf)の低いLEDを得るに不都合となる場合がある。

【0009】

本発明は、上記の従来技術の問題点を克服すべくなされたもので、素子駆動電流を発光層に拡散させるために好都合な低抵抗の導電層を簡易に形成でき、また、光学的に透明であり、尚且つLEDを構成するIII-V族化合物半導体層とのオーミック接触性に優れた化合物半導体材料から電流拡散層を構成して、順方向電圧等の電気的特性に優れた化合物半導体LEDを提供するものである。

【課題を解決するための手段】

【0010】

即ち、本発明は、(1) III-V族化合物半導体からなる発光層と、該発光層上に設けられたIII-V族化合物半導体からなる電流拡散層とを備えた化合物半導体発光ダイオードにおいて、前記電流拡散層が、導電性のリン化硼素系半導体から構成され、前記電流拡散層の室温での禁止帯幅が、前記発光層の室温での禁止帯幅よりも大きいことを特徴とする化合物半導体発光ダイオードである。

【0011】

(2) 前記電流拡散層が、単量体のリン化硼素、組成式 $\text{B}_\alpha\text{Ga}_\gamma\text{In}_{1-\alpha-\gamma}\text{P}$ ($0 < \alpha \leq 1, 0 \leq \gamma < 1$) で表されるリン化硼素・ガリウム・インジウム、組成式 $\text{BP}_{1-\delta}\text{N}_\delta$ ($0 \leq \delta < 1$) で表される窒化リン化硼素、組成式 $\text{B}_\alpha\text{P}_{1-\delta}\text{As}_\delta$ で表される砷化リン化硼素から選択された少なくとも一種以上から構成されていることを特徴とする(1)に記載の化合物半導体発光ダイオードである。

【0012】

(3) 前記電流拡散層の室温での禁止帯幅と、前記発光層の室温での禁止帯幅との差が、0.1 eV以上であることを特徴とする(1)又は(2)に記載の化合物半導体発光ダイオードである。

イオードである。

【0013】

(4) 前記電流拡散層の室温での禁止帯幅が、 $2.8\text{ eV} \sim 5.0\text{ eV}$ であることを特徴とする(1)乃至(3)の何れか1項に記載の化合物半導体発光ダイオードである。

【0014】

(5) 前記電流拡散層は、その室温でのキャリア濃度が $1 \times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ 以上であり、抵抗率が $5 \times 10^{-2}\text{ }\Omega \cdot \text{cm}$ 以下であり、厚さが 50 nm 以上、 5000 nm 以下であることを特徴とする(1)乃至(4)の何れか1項に記載の化合物半導体発光ダイオードである。

【0015】

(6) 前記電流拡散層と前記発光層との間に、III-V族化合物半導体からなるクラッド層が備えられ、前記クラッド層の室温での禁止帯幅が、前記発光層の室温での禁止帯幅よりも大きく、かつ前記電流拡散層の室温での禁止帯幅以下であることを特徴とする(1)乃至(5)の何れか1項に記載の化合物半導体発光ダイオードである。

【0016】

(7) 前記クラッド層がアルミニウム、ガリウム、及びインジウムを含有するIII-V族化合物半導体から構成され、前記電流拡散層は、アルミニウム、ガリウム、インジウムのうち少なくとも一種以上を含むリン化硼素系半導体から構成されていることを特徴とする(6)に記載の化合物半導体発光ダイオードである。

【0017】

(8) 前記電流拡散層と前記クラッド層として、リン化硼素系半導体から構成され、組成に勾配を付した組成勾配層が備えられていることを特徴とする(6)又は(7)に記載の化合物半導体発光ダイオードである。

【0018】

(9) 前記発光層が、組成式 $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_z\text{P}$ ($0 \leq X, Y, Z \leq 1, X+Y+Z=1$)で表されるリン化アルミニウム・ガリウム・インジウム混晶から構成され、前記電流拡散層又は前記クラッド層が、不純物を故意に添加していないアンドープのリン化硼素系半導体から構成されていることを特徴とする(1)乃至(8)の何れか1項に記載の化合物半導体発光ダイオードである。

【0019】

(10) 前記電流拡散層又は前記組成勾配層には、オーミック接触性の電極が接合されていることを特徴とする(1)乃至(9)の何れか1項に記載の化合物半導体発光ダイオードである。

【発明の効果】

【0020】

室温で広い禁止帯幅を有するリン化硼素系半導体層からなる電流拡散層は、素子駆動電流をクラッド層、発光層へ拡散させると共に、発光を外部へ取り出すための窓層としても有効に作用する。

【0021】

このため、本発明に依れば、電流拡散層が、発光層を超える広い禁止帯幅を室温で有し、且つ低抵抗の導電性のリン化硼素系半導体から構成されたことによって、素子駆動電流を発光領域に広範囲に拡散できる。また前記電流拡散層は、光学的に透明であり、かつIII-V族化合物半導体層からなる発光層とのオーミック接触性に優れ、簡易に形成できる。

このため、順方向電圧等の電気的特性に優れ、発光領域に於ける発光の強度を均一化でき、またその均一な強度の発光を吸収せずに外部に透過できる化合物半導体発光ダイオードが実現できる。

【0022】

更に、電流拡散層と発光層との中間に、III-V族化合物半導体からなるクラッド層

が備えられ、このクラッド層の室温での禁止帯幅が、発光層の室温での禁止帯幅を超え、かつ電流拡散層の室温での禁止帯幅以下であることによって、化合物半導体発光ダイオードの厚さ方向に対して、禁止帯幅を発光層から電流拡散層へ緩やかに変化させることができ、順方向電の低い化合物半導体発光ダイオードを提供できる。

【0023】

また、電流拡散層とクラッド層とが、広い禁止帯幅を有し、且つ低抵抗の導電性のリン化硼素系半導体から構成されたことによって、発光層の略全領域から、略一定の強度の発光が可能な化合物半導体発光ダイオードを提供できる。

【0024】

また、前記発光層が、組成式 $Al_x Ga_y In_z P$ ($0 \leq x, y, z \leq 1, x + y + z = 1$) で表されるリン化アルミニウム・ガリウム・インジウム混晶から構成されている場合、電流拡散層が、リンを構成元素として含むアンドープのリン化硼素から構成されたことによって、電流拡散層を広い禁止帯幅を有し、且つ低抵抗とすることができる。

このため、発光層の略全面に素子駆動電流を拡散でき、且つ発光層の全域から所望の波長の、均一な強度の発光をもたらす化合物半導体発光ダイオードを提供できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0025】

本発明の化合物半導体発光ダイオードは、III-V族化合物半導体からなる発光層と、発光層上に設けられた電流拡散層を備えている。

前記電流拡散層は、III-V族化合物半導体のリン化硼素系半導体から構成され、発光ダイオードを駆動するために順方向に流通された素子駆動電流を発光層に拡散させるようになっている。

【0026】

ここで、本明細書中、「リン化硼素系半導体」とは、硼素 (B) とリン (P) とを構成元素として含む立方晶閃亜鉛鉱結晶型のIII-V族化合物半導体であり、例えば、組成式 $B_\alpha Al_\beta Ga_\gamma In_{1-\alpha-\beta-\gamma} P_{1-\delta} As_\delta$ ($0 < \alpha \leq 1, 0 \leq \beta < 1, 0 \leq \gamma < 1, 0 < \alpha + \beta + \gamma \leq 1, 0 \leq \delta < 1$) で表される化合物や、組成式 $B_\alpha Al_\beta Ga_\gamma In_{1-\alpha-\beta-\gamma} P_{1-\delta} N_\delta$ ($0 < \alpha \leq 1, 0 \leq \beta < 1, 0 \leq \gamma < 1, 0 < \alpha + \beta + \gamma \leq 1, 0 \leq \delta < 1$) で表される化合物等が挙げられる。

特に、本発明で好適に利用できるのは、アルミニウム (Al) 等の易酸化性の元素を構成元素として含まず、例えば、単量体のリン化硼素 (BP)、組成式 $B_\alpha Ga_\gamma In_{1-\alpha-\gamma} P$ ($0 < \alpha \leq 1, 0 \leq \gamma < 1$) で表されるリン化硼素・ガリウム・インジウム、組成式 $BP_{1-\delta} N_\delta$ ($0 \leq \delta < 1$) で表される窒化リン化硼素、組成式 $B_\alpha P_{1-\delta} As_\delta$ で表される砒化リン化硼素等の複数のV族元素を含む混晶である。

【0027】

上記の本発明に係わる電流拡散層は、リン化硼素系半導体から構成され、発光層の室温での禁止帯幅 (band gap) よりも大きな禁止帯幅を有する。

電流拡散層の室温での禁止帯幅と、発光層の禁止帯幅との差は、0.1 eV以上が好ましく、これにより窓層としても十分に兼用できる電流拡散層を形成できる。

ここで、禁止帯幅は、吸収係数の光子エネルギー ($= h \cdot \nu$) 依存性などから求められる。また、屈折率 (n) 及び消衰係数 (k) の積値 ($= 2 \cdot n \cdot k$) の光子エネルギー依存性から求められる。

例えば、青色発光用の化合物半導体発光ダイオードとして、発光層がIII-V族化合物半導体からなり、その室温での禁止帯幅が2.7 eV以下 (以下 eV と示す。) である場合、この発光層上には、リン化硼素系半導体から構成され、室温の禁止帯幅が2.8 eV ~ 5.0 eV の電流拡散層が備えられる。

【0028】

電流拡散層は、リン化硼素系半導体から構成され、室温での禁止帯幅が2.8 eV ~ 5.0 eV であることが好ましく、これにより赤色光から緑色光等の可視光の発光を外部へ透過でき、電流拡散層が窓 (window) 層を兼用できる。

リン化硼素系半導体からなる電流拡散層の禁止帯幅が5.0 eVを超える場合、発光層或いはクラッド層等との障壁差が大となり、順方向電圧或いは閾値電圧の低い化合物半導体発光素子を得るに不利となるため好ましくない。

【0029】

また電流拡散層は、室温でのキャリア濃度が $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上であり、抵抗率が $5 \times 10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下の低抵抗のリン化硼素系半導体から構成されていることが好ましい。その層厚は、50ナノメートル（単位：nm）以上で5000nm以下とするのが適する。

このような低抵抗のリン化硼素系半導体層は、発光層からの発光を外部へ透過するための窓層を兼ねる電流拡散層としても有効に利用できる。

【0030】

リン化硼素系半導体から構成された電流拡散層は、ハロゲン（halogen）法、ハイドライド（hydride；水素化物）法やMOCVD（有機金属化学的気相堆積）法等の気相成長手段に依り形成される。また、分子線エピタキシャル法でも形成される（J. Solid State Chem.、133（1997）、269～272頁参照）。

例えば、n形の単量体のリン化硼素（BP）からなる電流拡散層の形成方法としては、トリエチル硼素（分子式： $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{B}$ ）とホスフィン（分子式： PH_3 ）を原料として用いた常圧（略大気圧）或いは減圧MOCVD法が適用できる。

n形の単量体のリン化硼素（BP）からなる電流拡散層を形成する際の原料供給比率（V／III比率、例えば $\text{PH}_3 / (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{B}$ ）は、200以上が好ましく、更に好ましくは400以上が適する。

ここで、本明細書において、「V／III比率」は、気相成長領域に供給する硼素等の第III族原子の濃度に対するリン等の第V族原子の濃度の比率を意味しているものとする。

更に、形成温度、V／III比率に加えて、形成速度を精密に制御すれば、発光層からの発光をほとんど吸収せずかつ禁止帯幅の大きなリン化硼素系半導体からなる電流拡散層を形成できる。

n形BP層の形成温度としては、700℃～1000℃が適する。

【0031】

また、p形の単量体のリン化硼素（BP）からなる電流拡散層を形成する場合も、トリエチル硼素（分子式： $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{B}$ ）とホスフィン（分子式： PH_3 ）を原料として用いた常圧（略大気圧）或いは減圧MOCVD法が適用できる。

このp形BP層の形成温度としては、1000℃～1200℃が適する。形成時の原料供給比率（V／III比率、例えば $\text{PH}_3 / (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{B}$ ）は、10～50とするのが適する。

特に、形成速度を2nm／分～30nm／分に設定することによって、室温での禁止帯幅が2.8 eV以上の単量体のリン化硼素からなる電流拡散層が得られる（特願2002-158282号参照。）。

【0032】

次に、放射再結合の効率を向上させて高強度の発光を得るために、III-V族化合物半導体からなる発光層に、III-V族化合物半導体からなるクラッド（clad）層が接合された化合物半導体発光ダイオードについて説明する。

この場合、電流拡散層はクラッド上に設けられるため、発光層と電流拡散層との間にクラッド層が位置することになる。

電流拡散層の室温での禁止帯幅は、クラッド層の常温での禁止帯幅よりも大きいことが好ましく、これにより発光層から出射される発光を出来るだけ吸収せずに、外部へ放出させることができる。

特に、クラッド層の室温での禁止帯幅が、発光層の室温での禁止帯幅よりも大きく、かつ電流拡散層の室温での禁止帯幅以下であることが更に好ましい。これにより、禁止帯幅

は電流拡散層側から発光層へ向かって減少することになり、LEDの順方向電圧、或いはLDの閾値が増加することを抑制できる。

【0033】

クラッド層が組成式 $Al_x Ga_y In_z P$ ($0 \leq X, Y, Z \leq 1$, $X+Y+Z=1$) で表される化合物等のように、Al、Ga、及びInの3つのIII族元素を構成元素として含むIII-V族化合物半導体から構成されている場合、電流拡散層は、Al、Ga、Inのうち少なくとも一種以上を含むリン化硼素系半導体から構成されていることが好ましい。

これによりクラッド層上に、電流拡散層を形成する際、クラッド層の表面に存在するIII族元素 (Al、Ga、及びIn) が、それらを構成元素として含む電流拡散層の成長を促すため電流拡散層を容易に形成でき、且つクラッド層との密着性に優れた電流拡散層が得られる。

このようなAl、Ga、Inのうち少なくとも一種以上を含むリン化硼素系半導体としては、前述した組成式 $B_\alpha Ga_\gamma In_{1-\alpha-\gamma} P$ ($0 < \alpha \leq 1$, $0 \leq \gamma < 1$) で表されるリン化硼素・ガリウム・インジウムだけでなく、例えばリン化硼素・インジウム ($B_\alpha In_{1-\alpha} P$: $0 < \alpha < 1$) や砒化リン化硼素・インジウム ($B_\alpha In_{1-\alpha} P_{1-\delta} As_\delta$: $0 < \alpha < 1$, $0 < \gamma < 1$) 等も挙げられる。

【0034】

クラッド層として、不純物を故意に添加 (ドーピング) したIII-V族化合物半導体、例えば亜鉛 (Zn) ドープ $Al_x Ga_y In_z P$ 等からなる層が備えられている場合、クラッド層から拡散して来る不純物 (亜鉛) に因り、発光層のキャリア濃度や伝導形が変化し、所望の電圧値とは異なる順方向電圧 (V_f) が印加されたり或いは所望の波長とは異なる波長の光が発光される場合があった。

これに対して、n形及びp形リン化硼素層等のアンドープ (undoped) のリン化硼素系半導体は、アンドープでしかも電気抵抗が小さい。

このため、クラッド層は、アンドープ (undoped) のリン化硼素系半導体から構成されていることが好ましい。この場合、クラッド層中の不純物の含有量が少ないため、発光層へ拡散する不純物量を低減でき、不純物の外部拡散に因る発光層の性質の変性を抑制できる。更に低抵抗であるため、素子駆動電流を発光層に拡散し易くなる。

なお、不純物を故意に添加しないアンドープのリン化硼素系半導体から構成された電流拡散層が備えられている場合も、前記したクラッド層と同様の効果が得られる。

【0035】

更に、アンドープの単量体リン化硼素から構成されたクラッド層や電流拡散層では、広い禁止帯幅を有する。このため、発光層が組成式 $Ga_x In_{1-x} N$ ($0 \leq X \leq 1$) で表される窒化ガリウム・インジウムや組成式 $GaN_{1-y} Py$ ($0 \leq Y \leq 1$) で表される窒化リン化ガリウムからなる場合、n形またはp形クラッド層としてアンドープの単量体リン化硼素層が適用できる。

特に、発光層が、組成式 $Al_x Ga_y In_z P$ ($0 \leq X, Y, Z \leq 1$, $X+Y+Z=1$) 等のリン (P) を構成元素として含む化合物半導体材料からなる場合、クラッド層は、アンドープの単量体リン化硼素層がより好適に適用できる。

発光層に構成元素としてリンが多量に含まれていると、電流拡散層、或いはクラッド層をなすリン化硼素系半導体層からのリン原子の濃度の差異が小さくなる。従って、電流拡散層或いはクラッド層から発光層への (P) 原子の拡散の原動力が小さくなるため、発光層の変性を抑制するに効果が奏される。

【0036】

発光層にクラッド層が接合された化合物半導体発光ダイオードでは、特に、電流拡散層とクラッド層として、組成に勾配 (組成勾配) を付したリン化硼素系半導体層 (以下、組成勾配層とも言う。) が備えられていることが好ましい。

組成勾配層には、組成勾配が、層厚の増加方向、すなわち発光層側から電流拡散層の上面側に向かって、禁止帯幅が増加するように形成されている。

例えば、組成勾配層がリン化硼素・ガリウム ($B_{1-x}Ga_xP$: $0 \leq X \leq 1$) から構成されている場合、層厚の増加方向に、硼素 (B) 組成比 ($= 1 - X$) が増加し、同時にガリウム (Ga) 組成比 ($= X$) が減少するように組成に勾配 (組成勾配) が設けられている。具体的には、発光層と接する部分では硼素組成比 ($= 1 - X$) が 0 のリン化ガリウム (GaP) から構成され、クラッド層から電流拡散層に向かって層厚が増加すると共に硼素組成比が増加し、電流拡散層の上面では硼素組成比が 1 の BP から構成されるように組成に勾配 (組成勾配) が設けられている。

【0037】

このようにリン化硼素系半導体層の組成に勾配 (組成勾配) が設けられたことによって、室温での禁止帯幅がリン化ガリウムの 2.2 eV から例えば 2.8 eV 以上に禁止帯幅を増加させることができ、かつ電流拡散層とクラッド層を兼ねることができる。

このように禁止帯幅が電流拡散層側から発光層へ徐々に減少するように組成勾配を付したリン化硼素系半導体層 (組成勾配層) が備えられたことによって、LED の順方向電圧、或いは LD の閾値が増加するのを抑制するに貢献できる。

【0038】

電流拡散層とクラッド層として、組成勾配層を形成する場合、禁止帯幅が直線的、段階的、或いは曲線的に変化するように組成勾配を変化させて組成勾配層を形成する。

組成勾配層のうち、クラッド層として機能する領域では、層厚の増加方向に禁止帯幅が漸次、増加するように勾配を設ける。

【0039】

電流拡散層上又は組成勾配層上には、 n 形または p 形オーミック電極が設けられている。電流拡散層又は組成勾配層が n 形リン化硼素系半導体から構成されている場合、オーミック電極としては、金 (Au) ・ゲルマニウム (Ge) 合金等の金 (Au) 合金等が適用できる。

電流拡散層又は組成勾配層が p 形リン化硼素系半導体から構成されている場合、オーミック電極としては、従来のニッケル (Ni) 単体、或いはその合金、金 (Au) ・亜鉛 (Zn) や金 (Au) ・ベリリウム (Be) 合金等が適用できる。

オーミック電極として重層構造のものを適用する場合、最上層は、結線 (bonding) を容易となすため、金 (Au) またはアルミニウム (Al) から構成するのが好適である。また、例えば、3 層の重層構造のオーミック電極にあつて、底面部と最上層との中間に設けられた中間層は、チタン (Ti)、モリブデン (Mo) 等の遷移金属或いは白金 (Pt) から構成され得る。

【0040】

電流拡散層や組成勾配層が、リン化硼素系半導体層から構成されたことによって、電流拡散層又は組成勾配層がクラッド層等の他の層よりも大きな禁止帯幅を有していても、この電流拡散層上又は組成勾配層上に良好なオーミック接触性の電極を形成できる。

これは、 $Al_xGa_{1-x}As$ や $Al_xGa_{1-x}In_zP$ から構成された従来の電流拡散層に比べて、リン化硼素系半導体から構成された電流拡散層や組成勾配層では、イオン (ion) 結合性が小さいため、禁止帯幅が広くとも、従来の半導体材料に比較して顕著に低抵抗な導電層が得られるからである。リン化硼素系半導体の一例として単量体のリン化硼素 (BP) では、アンドープ状態で $10^{19}\text{ cm}^{-3} \sim 10^{20}\text{ cm}^{-3}$ の高キャリア濃度の導電層が簡便に得られる。即ち、リン化硼素系半導体から構成された電流拡散層や組成勾配層では、禁止帯幅が大きいだけに発光の外部への透過性に優れ、且つ、電流拡散層や組成勾配層上に低接触抵抗のオーミック電極を形成できる。

【実施例】

【0041】

(第 1 実施例)

単量体のリン化硼素半導体から構成された電流拡散層を備えたリン化硼素系 LED を例にして、本発明を具体的に説明する。

【0042】

図1は、第1実施例のダブルヘテロ (DH) 接合構造のリン化硼素系LED10とその積層構造体11の断面構造を示す模式図である。ここで、図1は模式図であり、各層の厚さの比等の寸法は実際とは異なる場合がある。

積層構造体11は、亜鉛 (Zn) をドープしたp形の (100) -砒化ガリウム (GaAs) 単結晶基板100上に、亜鉛をドープしたp形のGaAsからなる緩衝層101、亜鉛をドープしたリン化アルミニウム・ガリウム・インジウム混晶 ($(\text{Al}_{0.70}\text{Ga}_{0.30})_{0.50}\text{In}_{0.50}\text{P}$) からなる下部クラッド層102、アンドープでn形の ($\text{Al}_{0.14}\text{Ga}_{0.86}$) $_{0.50}\text{In}_{0.50}\text{P}$ からなる発光層103、セレン (Se) をドープしたn形の ($\text{Al}_{0.70}\text{Ga}_{0.30}$) $_{0.50}\text{In}_{0.50}\text{P}$ からなる上部クラッド層104を、順次、堆積して形成した (J. Korean Association of Crystal Growth, 11 (5) (2001)、207-210頁参照。)。

基板100上の各層101~104は、一般的な減圧MOCVD手段に依り気相成長させた。

【0043】

($\text{Al}_{0.70}\text{Ga}_{0.30}$) $_{0.50}\text{In}_{0.50}\text{P}$ からなる上部クラッド層104上に、アンドープでn形のリン化硼素・インジウム ($\text{B}_{0.40}\text{In}_{0.60}\text{P}$) を堆積して電流拡散層105を形成した。

n形リン化硼素・インジウムから構成された電流拡散層105は、トリエチル硼素 (分子式: $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{B}$) を硼素 (B) 源とし、トリメチルインジウム (分子式: $(\text{CH}_3)_3\text{In}$) をインジウム源とし、ホスフィン (分子式: PH_3) をリン源とし、常圧 (略大気圧) 有機金属気相エピタキシー (MOVPE) 法により形成した。

【0044】

この電流拡散層105の形成条件は、室温での禁止帯幅が約4.3 eVである単量体のリン化硼素 (BP) を形成する際の条件と同様に、V/I I I 比率が800、成長温度が700℃、成長速度が30 nm/分とした。

電流拡散層105を構成するn形リン化硼素・インジウムの硼素 (B) 組成比は0.40とし、GaAsとは格子整合しないが、広い禁止帯幅が得られるようにした。またこのn形リン化硼素・インジウムから構成された電流拡散層105の層厚は700 nmとした。

【0045】

得られた電流拡散層105は、アンドープのn形 $\text{B}_{0.40}\text{In}_{0.60}\text{P}$ から構成され、室温での禁止帯幅は、2.5 eVとなった。

またキャリア濃度は $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ であり、室温での抵抗率は $2 \times 10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$ であった。

【0046】

この電流拡散層105の表面の全面に、通常真空蒸着法及び電子ビーム蒸着法に依り金 (Au)・ゲルマニウム (Ge) 合金膜、ニッケル (Ni) 膜、及び金 (Au) 膜を、順次、被着させた。

次に、結線用の台座 (pad) 電極を兼ねるn形オーミック電極106を設ける領域に限り、底面部をAu・Ge合金膜とする上記の3層重層電極を残置させるために、公知のフォトリソグラフィ技術を利用して選択的にパターニングを施した。

次に、n形オーミック電極106とする以外の領域に在るAu・Ge合金膜等をエッチングして除去し、電流拡散層105をなすn形リン化硼素・インジウム層の表面を露出させた。

【0047】

フォトレジスト材を剥離した後、再び、選択的パターニングを施し、個別の発光素子 (チップ) に裁断するために、線幅が50 μm であり、基板100の<110>結晶方位に平行に格子状の溝を設けた。

然る後、塩素を含むハロゲン系混合ガスを利用したプラズマドライエッチング手法に依り、上記のパターニングを施した領域に限定して、n形リン化硼素・インジウム層を選択

的にエッチングで除去した。

一方、p形GaAs単結晶基板100の裏面の全面には、一般の真空蒸着法に依り、金・ベリリウム(Au・Be)膜を被着させてp形オーミック電極107を形成した。

その後、GaAs基板100を、 $\langle 110 \rangle$ 結晶方位に平行に設けた線幅が $50\mu\text{m}$ の上記帯状の溝に沿って劈開し、一辺を $350\mu\text{m}$ とする正方形のLEDチップ10に分割した。

【0048】

n形オーミック電極106とp形オーミック電極107との間に、順方向に20mAの素子駆動電流を流通してLEDチップ10の発光特性を確認した。LED10からは中心の波長を 610nm とする橙色味を帯びた赤色光が放射された。

n形オーミック電極106の射影領域以外の発光層103の平面領域の略全面から発光が外部へもたらされるのが視認された。発光パターンの近視野像から、上記の射影領域以外の発光層103の領域からの発光の強度は略一定であるのが示された。このため、一般的な積分球を利用して測定される樹脂モールド以前のチップ(chip)状態での輝度は40ミリカンデラ(mcd)に達した。

電流拡散層105が、広い禁止帯幅を有しかつ低抵抗であるn形リン化硼素・インジウムから構成されたことによって、電流拡散層105が発光層103からの発光を外部へ透過するための窓層として兼用できた。

【0049】

また、n形オーミック電極106が、低抵抗のn形リン化硼素・インジウムからなる電流拡散層105上に設けられたことによって、順方向電圧(V_f)を2.3Vと低い値とすることができた。一方、逆方向電流を $10\mu\text{A}$ とした際の逆方向電圧は8Vを越える高値となった。

【0050】

(第2実施例)

硼素の組成に勾配を付したリン化硼素系半導体層(組成勾配層)が、電流拡散層を兼用するクラッド層として備えられたリン化硼素系半導体LEDを例にして本発明を具体的に説明する。

【0051】

図2は、第2実施例のリン化硼素系LED20の断面構造を示す模式図である。ここで、図2は図1と同様に模式図であり、各層の厚さの比等の寸法は実際とは異なる場合がある。

また、図1に示されたリン化硼素系LED10と同一の構成要素については、同一の符号を付して、その説明を省略する。

【0052】

第2実施例では、第1実施例のリン化硼素系LED10におけるセレン(Se)をドープしたn形の $(\text{Al}_{0.70}\text{Ga}_{0.30})_{0.50}\text{In}_{0.50}\text{P}$ からなる上部クラッド層104を薄膜クラッド層(以下、上部クラッド層と同じ符号104を付す。)として、その上に、アンドープでn形のリン化硼素・ガリウム混晶 $(\text{B}_\alpha\text{Ga}_{1-\alpha}\text{P}; 0 < \alpha < 1)$ からなる組成勾配層108を形成した。

セレン(Se)をドープしたn形 $(\text{Al}_{0.70}\text{Ga}_{0.30})_{0.50}\text{In}_{0.50}\text{P}$ から構成された薄膜クラッド層104は、層厚を 75nm とする以外は、上記の第1実施例の上部クラッド層104(層厚 $5\mu\text{m}$)と同様の方法で形成した。

【0053】

$\text{B}_\alpha\text{Ga}_{1-\alpha}\text{P}$ ($0 < \alpha < 1$) から構成された組成勾配層108は、 $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{B}/(\text{CH}_3)_3\text{Ga}/\text{PH}_3$ 系減圧MOCVD法により 750°C で形成した。層厚は 740nm とした。組成勾配層108の硼素(B)組成比(α)は、薄膜クラッド層104との接合界面では0.05とした。硼素組成比は、 $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{B}$ の気相成長系への供給量を一定に維持しつつ、 $(\text{CH}_3)_3\text{Ga}$ の供給量を経時的に一定の割合で減少させることにより、層厚の増加と共に、直線的な組成勾配を付し、表面で硼素(B)組成比(α)

) が 1.0、即ち、リン化硼素 (BP) となるように形成した。

【0054】

B_aGa_{1-a}P から構成された組成勾配層 108 の表面近傍の領域でのキャリア濃度は $8 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ であり、抵抗率は $6 \times 10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$ であった。

また、一般的な分光エリプソメータを使用して組成勾配層 108 の屈折率と消衰係数を計測し、この測定値を用いて組成勾配層 108 の禁止帯幅の平均値を算出した結果、約 3.1 eV であることがわかった。特に表層部 (表面から約 100 nm の深さに至る表層部) の室温での禁止帯幅は約 4.0 eV であった。このため、組成勾配層 108 を、窓層及び電流拡散層を兼用するクラッド層として利用できる。

【0055】

一般的な SIMS 分析手段で、組成勾配層 108 のリン (P) 原子濃度の深さ方向の分布を測定した。その結果、組成勾配層 108 のリン (P) が、薄膜クラッド層 104 を介して発光層 103 へ多量に拡散している様子は、特に認められなかった。

【0056】

次に、組成勾配層 108 の上面の中央部に、第 1 実施例に倣い、直径が約 $130 \mu\text{m}$ の平面視円形の n 形オーミック電極 106 を設けた。また、GaAs 基板 100 の裏面の全体には、上記の第 1 実施例に記載の如く、Au・Be 合金からなる p 形オーミック電極 107 を形成した。p 形オーミック電極 107 をなす Au・Be 合金膜の膜厚は約 $2 \mu\text{m}$ とした。

【0057】

次に、n 形オーミック電極 106 を形成するに併せて、基板 100 をなす (100) - GaAs 単結晶の [1. -1. 0] 及び [-1. -1. 0] 結晶方位に平行に格子状に形成した裁断線に沿って、個別のチップに分離、裁断した。これより、一辺を $400 \mu\text{m}$ とする平面視正方形の LED チップ 20 とした。

【0058】

LED チップ 20 の n 形オーミック電極 106 と p 形オーミック電極 107 との間に、20 mA の順方向電流を通流したところ、所望する中心波長を 610 nm とする赤橙色の発光が出射された。また、近視野発光像の観察に依り、チップ 20 の中央部の n 形オーミック電極 106 以外の発光領域からの均一な強度の発光がもたらされているのが確認された。

これより、素子駆動電流を発光面に拡散させるために、従来技術のようにクラッド層の平面上に複数の小型のオーミック電極を敢えて設ける煩雑さを要せずとも、本発明に依れば、素子動作電流を発光層 103 に広範囲に均一に拡散させられることが示された。また、一般的な積分球を使用して測定される発光の強度は約 44 mcd に達した。

【0059】

また、電流拡散層及び窓層を兼ねる組成勾配層 108 では、電流拡散層の表面側から発光層 103 に向けて禁止帯幅を漸次、減少させたため、順方向電流を 20 mA とした際の順方向電圧は 2.3 V の低値に抑えられ、逆方向電流を $10 \mu\text{A}$ とした際の逆方向電圧は 8 V であった。

【産業上の利用可能性】

【0060】

本発明によると、III-V 族化合物半導体からなる発光層を備えた各種発光波長の化合物半導体 LED として利用でき、特に高輝度が得られ、表示ディスプレイ用 LED や、光通信機器等の電子機器用の LED 等として利用できる。

【図面の簡単な説明】

【0061】

【図 1】 第 1 実施例の LED の断面構造を示す模式図である。

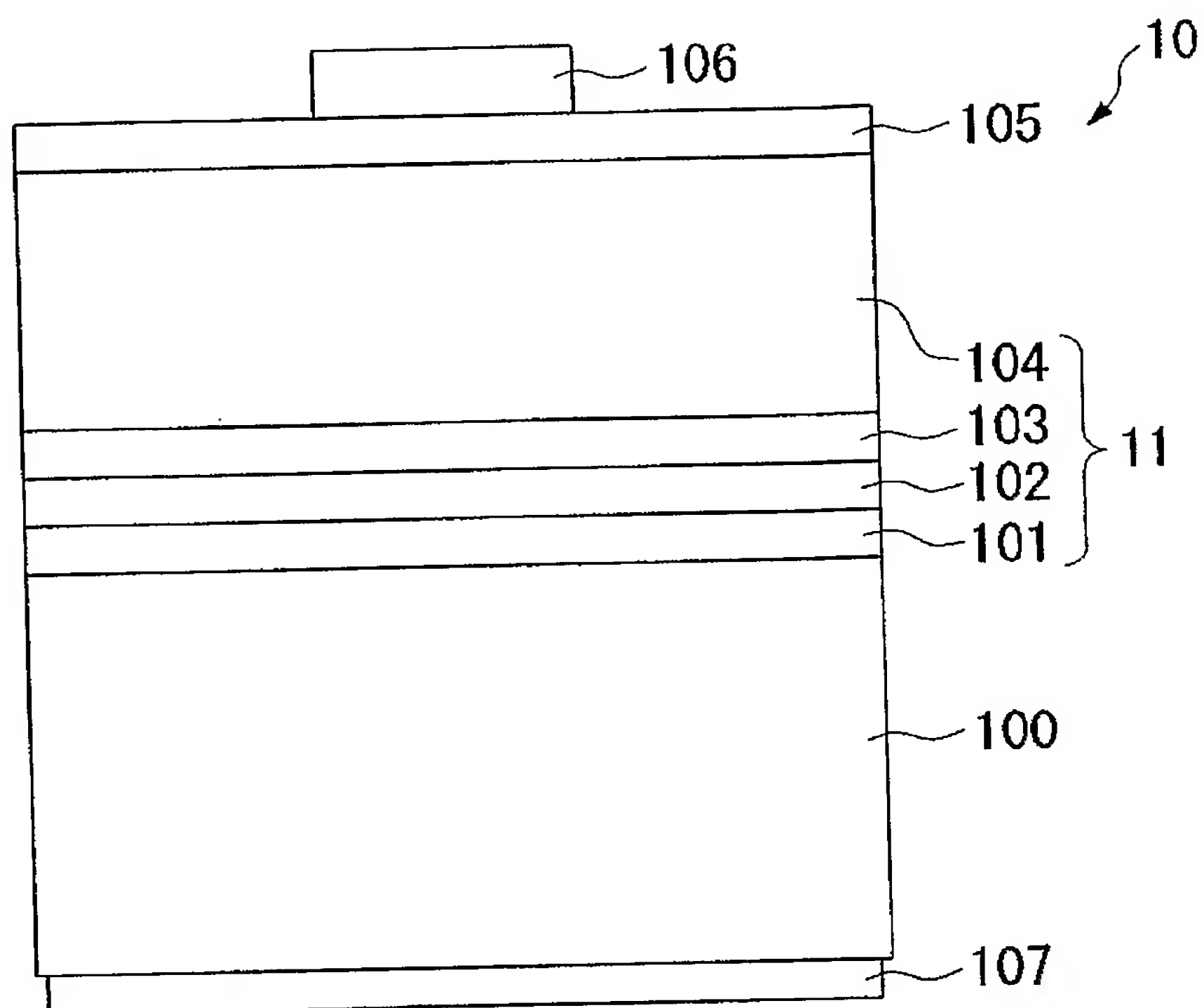
【図 2】 第 2 実施例の LED の断面構造を示す模式図である。

【符号の説明】

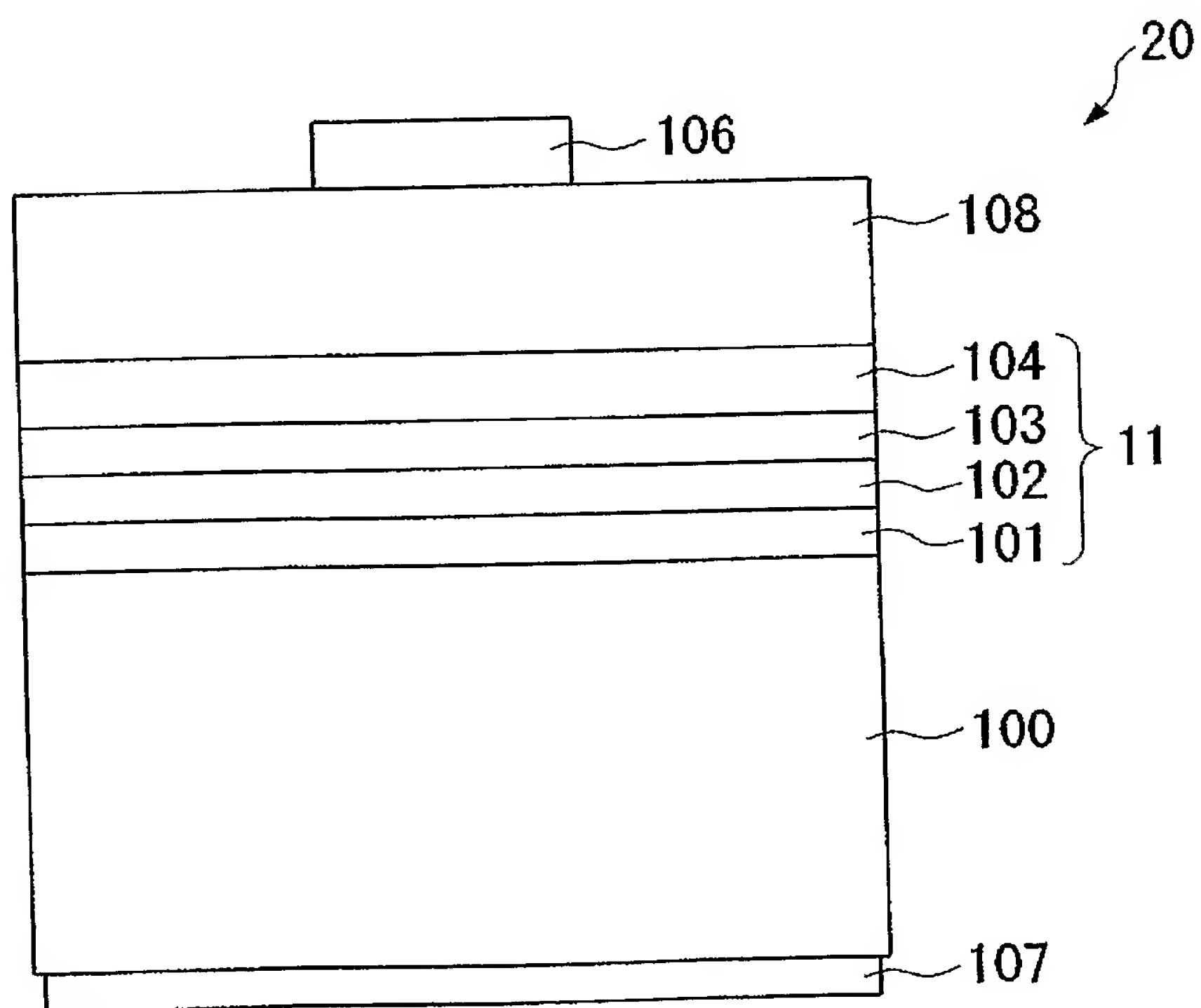
【0062】

1 0、2 0 L E D
1 1 積層構造体
1 0 0 G a A s 基板
1 0 1 p 形緩衝層
1 0 2 p 形下部クラッド層
1 0 3 n 形発光層
1 0 4 n 形上部クラッド層
1 0 5 電流拡散層
1 0 6 n 形オーミック電極
1 0 7 p 形オーミック電極
1 0 8 組成勾配層

【書類名】 図面
【図 1】



【図 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 素子駆動電流を発光層に拡散させるために好都合な低抵抗の導電層を簡易に形成でき、また、光学的に透明であり、尚且つLEDを構成するIII-V族化合物半導体層とのオーミック接触性に優れる化合物半導体材料から電流拡散層を構成して、順方向電圧等の電気的特性に優れる化合物半導体LEDを提供する。

【解決手段】 本発明は、III-V族化合物半導体からなる発光層103と、該発光層103上に設けられたIII-V族化合物半導体からなり発光ダイオードを駆動するために順方向に流通された素子駆動電流を前記発光層103に拡散させるための電流拡散層105とを備えた化合物半導体発光ダイオード10において、前記電流拡散層105が、導電性のリン化硼素系半導体から構成され、前記電流拡散層105の室温での禁止帯幅が、前記発光層103の室温での禁止帯幅よりも大きい構成とする。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 4 - 0 7 3 0 5 9
受付番号	5 0 4 0 0 4 2 4 3 7 9
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0 0 9 4
作成日	平成 1 6 年 3 月 1 6 日

< 認定情報・付加情報 >

【特許出願人】

【識別番号】	000002004
【住所又は居所】	東京都港区芝大門 1 丁目 1 3 番 9 号
【氏名又は名称】	昭和電工株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】	100064908
--------	-----------

【住所又は居所】	東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特許事務所
----------	----------------------------------

【氏名又は名称】	志賀 正武
----------	-------

【選任した代理人】

【識別番号】	100108578
--------	-----------

【住所又は居所】	東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特許事務所
----------	----------------------------------

【氏名又は名称】	高橋 詔男
----------	-------

【選任した代理人】

【識別番号】	100089037
--------	-----------

【住所又は居所】	東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特許事務所
----------	----------------------------------

【氏名又は名称】	渡邊 隆
----------	------

【選任した代理人】

【識別番号】	100101465
--------	-----------

【住所又は居所】	東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特許事務所
----------	----------------------------------

【氏名又は名称】	青山 正和
----------	-------

【選任した代理人】

【識別番号】	100094400
--------	-----------

【住所又は居所】	東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特許事務所
----------	----------------------------------

【氏名又は名称】	鈴木 三義
----------	-------

【選任した代理人】

【識別番号】 100107836

【住所又は居所】 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特
許事務所

【氏名又は名称】 西 和哉

【選任した代理人】

【識別番号】 100108453

【住所又は居所】 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特
許事務所

【氏名又は名称】 村山 靖彦

特願 2 0 0 4 - 0 7 3 0 5 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 0 0 4]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝大門 1 丁目 1 3 番 9 号

氏 名

昭和電工株式会社